

增刊

掠入射X射线衍射研究Si覆盖层对Ge/Si量子点微结构的影响

何庆¹, 贾全杰¹, 姜晓明¹, 崔健², 蒋最敏²

1 中国科学院高能物理研究所 北京 100039)

(2 复旦大学应用表面物理实验室 上海 200433

收稿日期 2003-11-21 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 利用掠入射X射线衍射和常规X射线衍射研究了Si(001)上的Ge量子点在不同厚度的Si覆盖层下微结构的变化,同时用AFM研究了其形貌变化.实验结果表明在小的覆盖度下,量子点中组分的变化已十分明显,同时量子点的形状也发生了明显的变化.

关键词 [量子点](#) [组分](#) [应变](#) [掠入射X射线衍射](#)

分类号

DOI:

通讯作者:

何庆 heqing@mail.ihep.ac.cn

作者个人主页: 何庆¹; 贾全杰¹; 姜晓明¹; 崔健²; 蒋最敏²

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(651KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“量子点”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [何庆](#)

· [贾全杰](#)

· [姜晓明](#)

· [崔健](#)

· [蒋最敏](#)